

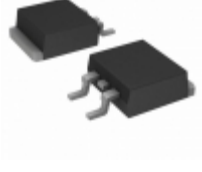







	<p>IPB70N10S3-12</p>
	<p>codice articolo del costruttore: IPB70N10S3-12</p> <p>Costruttore / Marca: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Parte della descrizione: IPB70N10S3-12 Infineon Technologies</p> <p>Schede tecniche:  IPB70N10S3-12.pdf</p> <p>Stato di RoHs: Senza piombo / RoHS conforme</p> <p>Condizione di scorta: New original, 3975 pcs Stock Available.</p> <p>Nave da: Hong Kong</p> <p>Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

specificazioni

Numero di parte	IPB70N10S3-12
fabbricante	International Rectifier (Infineon Technologies)
Descrizione	IPB70N10S3-12 Infineon Technologies
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	3975 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
temperatura di esercizio	-55°C ~ 175°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore / involucro	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Contenitore dispositivo fornitore	PG-TO263-3-2
Dissipazione di potenza (max)	125W (Tc)
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	100V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	70A (Tc)
Rds On (max) a Id, Vgs	11.3 mOhm @ 70A, 10V
Vgs (th) (max) a Id	4V @ 83µA
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	4355pF @ 25V
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
imballaggio	Tape & Reel (TR)

IPB70N10S3-12 è nuovo originale in magazzino, ricerca datasheet IPB70N10S3-12, PDF, inventario Y-IC.com online, ordine IPB70N10S3-12 International Rectifier (Infineon Technologies) con garanzia e garanzia. RFQ IPB70N10S3-12: Info@Y-IC.com

Potresti essere anche interessato:

 <p>IPB70N04S3-07 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>	 <p>IPB70N04S4-06 IPB70N04S4-06 </p>	 <p>IPB70N10S3L12ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 70A TO263-3</p>	 <p>IPB70N10S2L-16 International Rectifier (Infineon Technologies) IPB70N10S2L-16 INFINEON</p>
 <p>IPB70N04S406ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 70A TO263-3-2</p>	 <p>IPB70N10S312ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 70A TO263-3</p>	 <p>IPB65R660CFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 6A TO263</p>	 <p>IPB70N10S3L-12 IPB70N10S3L-12 </p>

Hot Parts

Di Più

⊗ IPB60R299CP	↔ IPB60R299CPA	⇒ IPB60R380C6	D IPB60R385CP	⇒ IPB60R520CP
⊣ IPB60R600C6	⊗ IPB60R600CP	D IPB60R950C6	⇒ IPB65R099C6	⇒ IPB65R110CFD
⊗ IPB65R110CFDA	⊣ IPB65R190CFD	⊗ IPB65R190CFDA	↔ IPB65R280C6	⇒ IPB65R280E6
D IPB65R310CFD	⊗ IPB65R310CFDA	⊣ IPB65R380C6	⊗ IPB65R420CFD	⇒ IPB65R600C6
⇒ IPB65R660CFD	↔ IPB65R660CFDA	⊗ IPB70N04S3-07	⊣ IPB70N04S4-06	⇒ IPB70N10S2L-16
↔ IPB70N10S3L-12	⇒ IPB70N10SL-16	D IPB70P04P4-09	⊗ IPB77N06S-09	⊣ IPB77N06S2-12
⊗ IPB77N06S3-09	D IPB79CN10NG	⇒ IPB80N03S4L-02	↔ IPB80N03S4L-03	⇒ IPB80N04S2-04
⊣ IPB80N04S2-H4	⊗ IPB80N04S2L-03	↔ IPB80N04S3-04	⇒ IPB80N04S3-H4	⇒ IPB80N04S4-03
⊗ IPB80N04S4-04	⊣ IPB80N04S4L-04	⊗ IPB80N06S2-05	D IPB80N06S2-07	⇒ IPB80N06S2-08
↔ IPB80N06S2-09	⊗ IPB80N06S2L-05	⊣ IPB80N06S2L-06	⊗ IPB80N06S2L-07	⇒ IPB80N06S2L-11

Contact us: Info@Y-IC.com

AGGIUNGI: Unità A5-B5 n. 509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited